

2017年10月3日

各位

住友金属鉱山株式会社
加賀電子株式会社

S i C（シリコンカーバイド）基板開発会社の株式譲渡契約締結
および合弁契約締結について

住友金属鉱山株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 中里佳明 以下、住友金属鉱山）と加賀電子株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 門良一 以下、加賀電子）は、住友金属鉱山が加賀電子の子会社である株式会社サイコックス（本社：東京都千代田区 代表取締役社長 関森俊幸 以下、サイコックス）の株式の51%を取得することで合意し、2017年10月2日付で株式譲渡契約および合弁契約を締結しましたのでお知らせいたします。なお、株式譲渡の実行および合弁の開始は2017年10月30日を予定しています。

S i Cは、主に電力を制御する用途で使用される半導体材料です。特にハイブリッド車や電気自動車などの駆動制御装置で要求される大容量領域（大電流・高耐電圧）において、エネルギーの損失を低減できる優れた材料として、今後、新たな市場の創生が見込まれています。

サイコックスは、接合技術を応用したS i C基板^(*)の製造技術を保有する開発会社であり、同社の接合技術は、S i Cの課題である基板コストを大幅に低減するものです。

住友金属鉱山と加賀電子は、サイコックスのS i C基板製造技術に住友金属鉱山の基板生産技術を融合させることによりS i C基板の量産検証を促進し、加賀電子のエレクトロニクス分野における情報収集力と販売網の活用により、速やかに市場のニーズに応えてまいります。

* 接合技術を応用したS i C基板とは

S i C多結晶基板上にS i C単結晶基板を薄く接合することで構成された基板です。多結晶基板を支持基板とすることで高価な単結晶基板の使用量を減らし、大幅な低コスト化が可能となります。同基板を用いて作製された半導体デバイスは、単結晶単体で構成されたSiC基板と同様の製造プロセスを用い、同等のデバイス特性が得られます。

ご参考（10月3日現在）

株式会社サイコックスの概要

本店所在地：東京都千代田区神田松永町 20 番地

資本金：186,625 千円

代表者：関森 俊幸

社員数：9 名

事業概要：パワー半導体用 S i C 基板の開発・製造・販売

（本件に関するお問い合わせ）

住友金属鉱山株式会社

広報 I R 部 元木 秀樹

Tel : 0 3 - 3 4 3 6 - 7 7 0 5

Fax : 0 3 - 3 4 3 4 - 2 2 1 5

加賀電子株式会社

秘書・広報室長 腰山 貴文

Tel : 0 3 - 5 6 5 7 - 0 1 0 6

Fax : 0 3 - 3 2 5 4 - 7 1 3 3